

Учёному секретарю  
диссертационного совета Д 002.204.01  
к.ф.-м.н. В.В. Выоркову

**Отзыв на автореферат диссертации  
Михайловича Сергея Викторовича «Частотные и шумовые параметры  
наногетероструктурных полевых транзисторов на основе AlGaN/GaN с разной  
толщиной барьера слоя»,**

представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук, по  
специальности: 05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,  
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах».

Диссертационная работа Михайловича Сергея Викторовича посвящена решению  
одного из актуальных вопросов современной твердотельной СВЧ электроники –  
исследованию частотных и шумовых свойств полевых транзисторов на основе  
гетероструктур AlGaN/GaN. Актуальность тематики обусловлена взрывным ростом  
производства приборов на основе GaN, показывающим значительные преимущества для  
мощных, и в последнее время, для высокочастотных и малошумящих приборов СВЧ  
твердотельной электроники.

Среди наиболее интересных научных и практических результатов, полученных  
автором, необходимо отметить следующее: уменьшение значения высокочастотного  
коэффициента шума при уменьшении толщины барьера слоя и уменьшении ёмкостной  
связи между затвором и стоком; впервые обнаруженную зависимость коэффициента шума  
от произведения квадрата максимальной частоты усиления по току на выходное  
сопротивление, а также разработанный автором метод экстракции параметров  
малосигнальных шумовых моделей полевых транзисторов на основе нитрида галлия.

По содержанию автореферата и диссертации имеются некоторые замечания:

1) не приводится информация о ширине затворной секции исследованных  
транзисторов; 2) недостаточно описан итерационный алгоритм поиска минимума целевой  
функции (напр.: секущих, касательных и т.п.) при экстракции значений элементов  
малосигнальной шумовой модели полевого транзистора.

Указанные замечания не снижают высокой оценки работы в целом.  
Диссертационная работа Михайловича Сергея Викторовича «Частотные и шумовые  
параметры наногетероструктурных полевых транзисторов на основе AlGaN/GaN с разной  
толщиной барьера слоя» является законченной научно-квалификационной работой,  
содержит новые научные и практические результаты, прошла широкую апробацию.  
Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к  
кандидатским диссертациям, а диссертант Михайлович Сергей Викторович заслуживает  
присвоения ему искомой учёной степени кандидата физико-математических наук по  
специальности 05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,  
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах».

Кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры № 67 «Физика конденсированных сред»  
Национального исследовательского ядерного университета  
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ)  
тел.: 8 (495) 788-56-99, доб. 8170  
e-mail: ivasilevskii@mail.ru  
115409, г. Москва, Каширское ш. 31.

И.С. Васильевский

10 Ноя 2016

Подпись удостоверяю  
Заместитель начальника отдела  
документационного обеспечения  
НИЯУ МИФИ



*Иван Ильинична Гавасова Сергеевна*